



三洋半導体
ニュース

No. 294B

N116

2SD416

シリコンNPN三重拡散型トランジスタ
20° 110° 水平偏向出力用

No. 294A とさしかえてください。

暫定規格

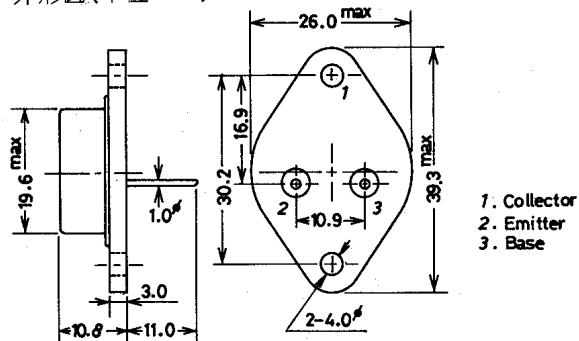
絶対最大定格/ $T_a=25^\circ\text{C}$

コレクタ・ベース電圧	V_{CB0}	1500	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CE0}	400	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EB0}	6	V
コレクタ電流	I_C	7	A
ピークコレクタ電流	I_{CP}	14	A
コレクタ損失	P_C	50	W
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存周囲温度	T_{stg}	-40~+150	$^\circ\text{C}$

電気的特性/ $T_a=25^\circ\text{C}$

		min	typ	max	単位
コレクタしゅ断電流	$I_{CB0(1)}$ $V_{CB}=1000\text{V}, I_E=0$			0.1	mA
	$I_{CB0(2)}$ $V_{CB}=1500\text{V}, I_E=0$			1.0	mA
エミッタしゅ断電流	I_{EB0} $V_{EB}=6\text{V}, I_C=0$			1.0	mA
直流電流増幅率	h_{FE} $V_{CE}=5\text{V}, I_C=5.5\text{A}$	3.5			
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$ $I_C=5.5\text{A}, I_B=1.6\text{A}$			1.5	V
降下時間	t_f $I_{CP}=5.4\text{A}$, 指定回路による。			1.0	μs
安全動作領域	ASO	別紙 ASO図参照			

外形図(単位: mm)



1. Collector
2. Emitter
3. Base